

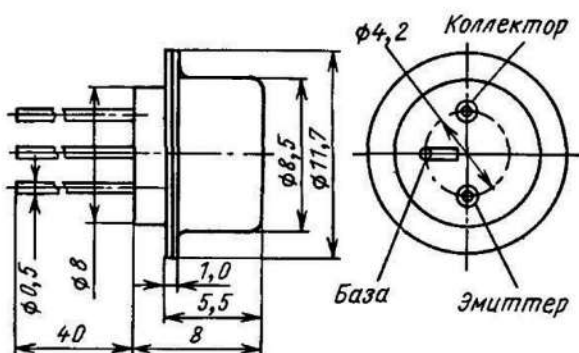
## МП16, МП16А, МП16Б

Транзисторы германиевые сплавные *p-n-p* переключаемые  
низкочастотные маломощные

Предназначены для применения в схемах переключения и формирования импульсов

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г



### Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при  $U_{КБ} = 5 \text{ В}$ ,  $I_{Э} = 1 \text{ мА}$  не менее

МП16, МП16А . . . . .	1 МГц
МП16Б . . . . .	2 МГц

Время переключения при  $U_{КЭ} = 15 \text{ В}$ ,  $R_{К} = 1,5 \text{ кОм}$  не более

МП16 . . . . .	2 мкс
МП16А . . . . .	1,5 мкс
МП16Б . . . . .	1 мкс

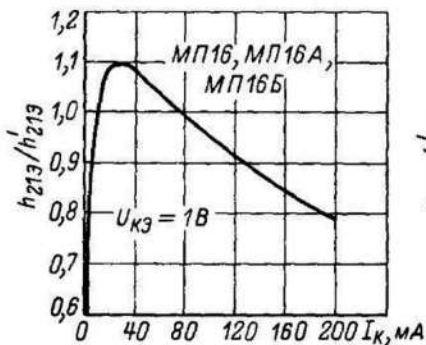
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при  $U_{КЭ} = 1 \text{ В}$ ,  $I_{К} = 10 \text{ мА}$ .

при $T = 293 \text{ К}$	
МП16 . . . . .	20–35
МП16А . . . . .	30–50
МП16Б . . . . .	45–100
при $T = 213 \text{ К}$	
МП16 . . . . .	10–35

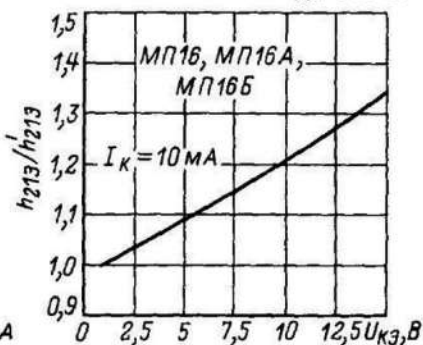
МП16А . . . . .	15–50
МП16Б . . . . .	23–100
при $T = 343$ К.	
МП16 . . . . .	20–80
МП16А . . . . .	30–100
МП16Б . . . . .	45–200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	0,15 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 10$ мА, $I_B = 1$ мА не более . . . . .	0,35 В
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = 15$ В, $U_{БЭ} =$ $= 0,5$ В не более	
при $T = 293$ К . . . . .	25 мкА
при $T = 343$ К . . . . .	200 мкА
Импульсный обратный ток коллектор-эмиттер при 293 К, $U_{КЭ} = 12$ В, $R_K = 1,5$ кОм не более . . . . .	400 мкА

### Предельные эксплуатационные данные

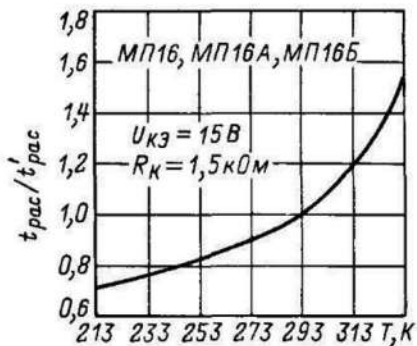
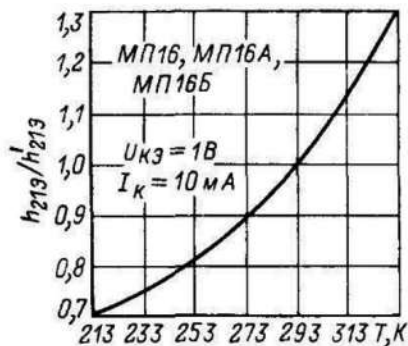
Постоянное напряжение коллектор-база . . . . .	15 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{ЭБ} \leq$ $\leq 2$ кОм . . . . .	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база . . . . .	15 В
Импульсный ток коллектора . . . . .	300 мА
Импульсный ток эмиттера . . . . .	300 мА
Среднее значение тока эмиттера . . . . .	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность:	
при $T = 213 - 318$ К, $p \geq 6666$ Па . . . . .	200 мВт
при $T = 213 - 318$ К, $p = 665$ Па . . . . .	100 мВт
при $T = 343$ К . . . . .	75 мВт
Общее тепловое сопротивление * . . . . .	200 К/Вт
Температура перехода . . . . .	358 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до 343 К



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от тока коллектора.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-эмиттер.



Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от температуры.

Зависимость относительного времени расслабления от температуры.

Зависимость относительного напряжения насыщения база-эмиттер от температуры.

